
	<h2>SIJ420DP-T1-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SIJ420DP-T1-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Siliconix</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 20V 50A PPAK SO-8</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SIJ420DP-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 7038 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SIJ420DP-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 50A PPAK SO-8
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	7038 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Verlustleistung (max)	4.8W (Ta), 62.5W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	50A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.6 mOhm @ 15A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	90nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3630pF @ 10V
Verpackung	Original-Reel®

SIJ420DP-T1-GE3 ist neu im Original. Suche SIJ420DP-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SIJ420DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SIJ420DP-T1-GE3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SIJ438DP-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 80A PPAK SO-8L</p>	 <p><b>SIJ438DP-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 40V 80A PPAK SO-8L</p>	 <p><b>SIJ458DP-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 60A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SIJ420DP-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 50A PPAK SO-8</p>
 <p><b>SIJ458DP-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 60A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SIJ400DP-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 32A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SIJ456DP-T1-GE3</b> VISHAY VISHAY SOT669</p>	 <p><b>SIJ458DP-T1-E3</b> VISHAY SIJ458DP-T1-E3 VISHAY</p>

### heiße Teile

Mehr

08055A681JAT4P	1827625-1	2MBI150U2A-060	ADM211ARS	AMS2910CM-2.5
AT34C02B-10TU-2.7	CC0402JRNPO9BN680	CC1812JKNPOCBN101	CM450DZ-24A	CM150MD-12H
CX06815-25	DAC312HS	GQM1875C2E2R4BB12D	HD100114	HT-261UD5/BP5
IR51H214	KBPC2510	L03ESDL5V0CE2	L78L12ACZ-AP	LM3464MHX/NOPB
LM385M3X-2.5/NOPB	LP4060AB5F	MAX688CUA	MBRB1035-E3/81	MIC5235-5.0BM5
MUN2111T1G	PSB21525HV2.1	S-80929CNMC-G8Z-T2	SBR30200CTFP-G	SFT1307-TL-E
SIJ400DP-T1-GE3	SIJ400DP-T1-GE3	SIJ420DP-T1-GE3	SIJ458DP-T1-E3	SIJ462DP-T1-GE3
SIJ462DP-T1-GE3	SIJ484DP-T1-GE3	SIJ484DP-T1-GE3	SIJ800DP-T1-E3	SIL10E-05S1V2H
SM8707HV-G	SN74F158AN	STF32NM50N	TD380N18KOF	TLC25L4BCDR
TOP254YN	UA7812CKTTR	UMK325B7475KM-T	VS-20CTH03-1PBF	WSL25121L000JEA

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited